

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Чеботарев Сергей Николаевич
2	Дата рождения (полная)	26.02.1982
3	Гражданство	Россия
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук (01.04.07 – физика конденсированного состояния)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент (01.04.07 – физика конденсированного состояния)
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	Россия, 346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова https://www.npi-tu.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования
	Тип организации	Высшее учебное заведение
	Наименование подразделения	Ректорат
	Должность	Проректор по образовательной деятельности
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<p>1. A.S. Pashchenko, L.S. Lunin, E.M. Danilina, S.N. Chebotarev, Variation of the photoluminescence spectrum of InAs/GaAs heterostructures grown by ion-beam deposition, Beilstein J. Nanotechnol. 9 (2018) P. 2794–2801. https://doi.org/10.3762/bjnano.9.261.</p> <p>2. S.N. Chebotarev, V.A. Irkha, A.A.A. Mohamed, Low-energy ion technique for semiconductor surface preparation, Solid State Phenomena. 284 (2018) P. 198–203. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.284.198.</p> <p>3. D.L. Alfimova, L.S. Lunin, M.L. Lunina, A.S. Pashchenko, S.N. Chebotarev, A.E. Kazakova, D.A. Arustamyan, Investigation of the structural perfection of thin-film InAlGaPAs/GaAs heterostructures, J. Surf. Investig. 12 (2018) P. 466–472. https://doi.org/10.1134/S1027451018030047.</p> <p>4. A.S. Pashchenko, L.S. Lunin, S.N. Chebotarev, M.L. Lunina, Study of the structural and luminescence properties of InAs/GaAs heterostructures with Bi-doped potential barriers, Semiconductors. 52 (2018) P. 729–733. https://doi.org/10.1134/S1063782618060180.</p> <p>5. D.L. Alfimova, L.S. Lunin, M.L. Lunina, D.A. Arustamyan, A.E. Kazakova, S.N. Chebotarev, Growth and properties of isoparametric InAlGaPAs/GaAs heterostructures, Semiconductors. 51 (2017) P. 1377–1384. https://doi.org/10.1134/S1063782617100037.</p> <p>6. D.L. Alfimova, L.S. Lunin, M.L. Lunina, A.S. Pashchenko, S.N. Chebotarev, Thin-layer GaInSbAsPBi/GaSb heterostructures obtained from liquid phase in a temperature-gradient field, Crystallogr. Reports. 62 (2017) P. 139–143. https://doi.org/10.1134/S1063774517010047.</p>	

7. S.N. Chebotarev, A.N. Yatsenko, V.N. Lozovskii, A.A.A. Mohamed, G.A. Erimeev, Zone thermal recrystallization of thin layers from a discrete source, *ARPN J. Eng. Appl. Sci.* 12 (2017) P. 1453–1457.
8. S.N. Chebotarev, A.S. Pashchenko, L.S. Lunin, E.N. Zhivotova, G.A. Erimeev, M.L. Lunina, Obtaining and doping of InAs-QD/GaAs(001) nanostructures by ion beam sputtering, *Beilstein J. Nanotechnol.* 8 (2017) P. 12–20. <https://doi.org/10.3762/bjnano.8.2>.
9. D.L. Alfimova, L.S. Lunin, M.L. Lunina, A.S. Pashchenko, S.N. Chebotarev, Effect of bismuth on parameters of a GaInSbAsP solid solution grown on GaSb substrates, *Inorg. Mater.* 53 (2017) P. 57–64. <https://doi.org/10.1134/S0020168517010010>.
10. S.N. Chebotarev, A.N. Yatsenko, L.S. Lunin, Features of zone thermal recrystallization of germanium layers grown on silicon substrates from a discrete source, *Solid State Phenomena.* 265 (2017) P. 620–626. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.265.620>.
11. D.L. Alfimova, L.S. Lunin, M.L. Lunina, A.E. Kazakova, A.S. Pashchenko, S.N. Chebotarev, Synthesis and properties of $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{1-x-y}\text{P}_z\text{As}_{1-z}\text{GaAs}$ heterostructures, *Inorg. Mater.* 53 (2017) 1217–1227. <https://doi.org/10.1134/S0020168517120019>.
12. S.N. Chebotarev, A.S. Pashchenko, V.A. Irkha, M.L. Lunina, Morphology and Optical Investigations of InAs-QD/GaAs Heterostructures Obtained by Ion-Beam Sputtering, *J. Nanotechnol.* 5340218 (2016). <https://doi.org/10.1155/2016/5340218>.
13. S.N. Chebotarev, A.S. Pashchenko, L.S. Lunin, V.A. Irkha, Regularities of ion-beam-induced crystallization and properties of InAs-QD/GaAs(001) semiconductor nanoheterostructures, *Nanotechnologies Russ.* 11 (2016) 435–443. <https://doi.org/10.1134/S1995078016040030>.
14. D.L. Alfimova, L.S. Lunin, M.L. Lunina, A.S. Pashchenko, S.N. Chebotarev, Growth and properties of GaInPSbAs isoperiodic solid solutions on indium arsenide substrates, *Phys. Solid State.* 58 (2016) 1751–1757. <https://doi.org/10.1134/S1063783416090055>.

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты